

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН,
ФТИ ИМ. С. У. УМАРОВА АН РТ
КУЛЯБСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АБУАБДУЛОХ РУДАКИ
1-ое информационное сообщение
VI-ой международной конференции
«Физико-химические основы получения и исследования комплекса свойств
полупроводниковых, композиционных и диэлектрических материалов»

В рамках сотрудничества государств-участников СНГ в ноябре 2013г в г. Куляб проводится (КГУ) VI международная научно-техническая конференция «Физико-химические основы получения и исследования комплекса свойств полупроводниковых, композиционных и диэлектрических материалов».

На конференции предполагается заслушать и обсудить доклады по следующей тематике:

1. Технология получения и исследования полупроводниковых, композиционных и диэлектрических материалов.
2. Физико-химические основы получения, легирование и свойства полупроводниковых материалов.
3. Физико-химические основы получения и свойства диэлектрических материалов.
4. Технологические свойства полупроводниковых, композиционных и диэлектрических материалов.
5. Термоэлектрические и теплофизические свойства полупроводниковых, композиционных и диэлектрических материалов.
6. Эксплуатационные свойства полупроводниковых, композиционных и диэлектрических материалов.
7. Оптические и фотоэлектрические свойства полупроводниковых, композиционных и диэлектрических материалов.

Тезисы докладов предполагается издать до начала конференции.

Оргкомитет приглашает Вас принять участие в работе конференции. Желающие принять участие в работе конференции должны выслать тезисы докладов до 25 ноября 2011 года по адресу: Республика Таджикистан, г. Куляб, ул. С. Сафарова 16, КГУ, Оргкомитет международной конференции «Физико-химические основы получения и исследования комплекса свойств полупроводниковых, композиционных и диэлектрических материалов».

О требованиях к рукописям тезисов докладов, представляемых на международную научно-техническую конференцию: «Физико-химические основы получения и исследования комплекса свойств полупроводниковых, композиционных и диэлектрических материалов».

1. Рукопись тезисов докладов должны быть тщательно отредактированы и качественно напечатаны, (представляется для издания ротاپринтным способом), в совершенно законченном виде и дальнейшему исправлению не подлежит.
2. Объем рукописи не более одного листа напечатанных на компьютере шрифт Times New Roman с размером 14 через полтора интервала на одной стороне листа бумаги хорошего качества, формата 160 x 260 мм, верхнее поля – по 25 мм правое поля – 10 мм лицевое поле (левое)- 30 мм.
3. Рукопись тезисов представляется в электронных версиях. К рукописи прилагаются сведения об авторах.
4. Второй экземпляр должен быть подписан автором и отсканирован.
5. При пересылке почтой тезисы докладов не сгибать, использовать конверты соответствующего размера и скоросшиватель.
6. При невыполнении указанных требований тезисы не будут включаться в сборник.
7. Срок приставления тезисов и докладов до 25.11.2013г.

Адрес: cssckulob@rambler.ru

Shubai-ilm@mail.ru , kgurector@mail.ru

тел: +992 83322 23507.

+992 907796289.

О Р Г К О М И Т Е Т